

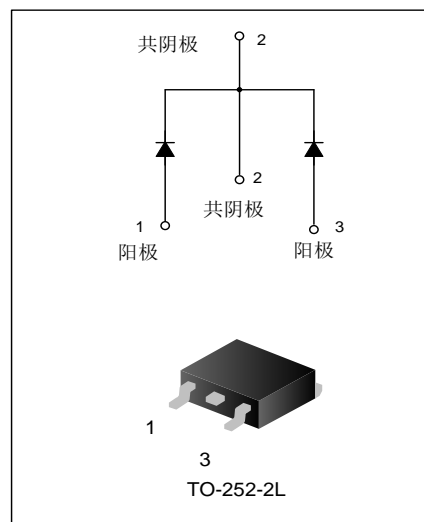
10A、200V肖特基整流管

描述

SBD10C200AD 是采用硅外延工艺制作而成的肖特基整流二极管，广泛应用于开关电源、保护电路等各类电子线路中。

特点

- ◆ 具有过压保护的保护环境结构
- ◆ 高电流冲击能力
- ◆ 低功耗，高效率
- ◆ 正向压降低



产品规格分类

产品名称	封装形式	打印名称	环保等级	包装方式
SBD10C200AD	TO-252-2L	10C200A	无卤	料管
SBD10C200ADTR	TO-252-2L	10C200A	无卤	编带

极限参数(除非特殊说明, $T_c=25^\circ\text{C}$)

参数	符号	额定值	单位
最大反向峰值电压	V_{RRM}	200	V
正向平均整流电流	I_{FAV}	10	A
正向峰值浪涌电流@8.3ms	I_{FSM}	150	A
工作结温范围	$T_J^{(1)}$	-55~150	$^\circ\text{C}$
芯片存储温度范围	T_{STG}	-55~150	$^\circ\text{C}$

注 1: $\frac{dP_{tot}}{dT_J} < \frac{1}{R_{th(j-a)}}$ 避免器件热失控的使用条件。

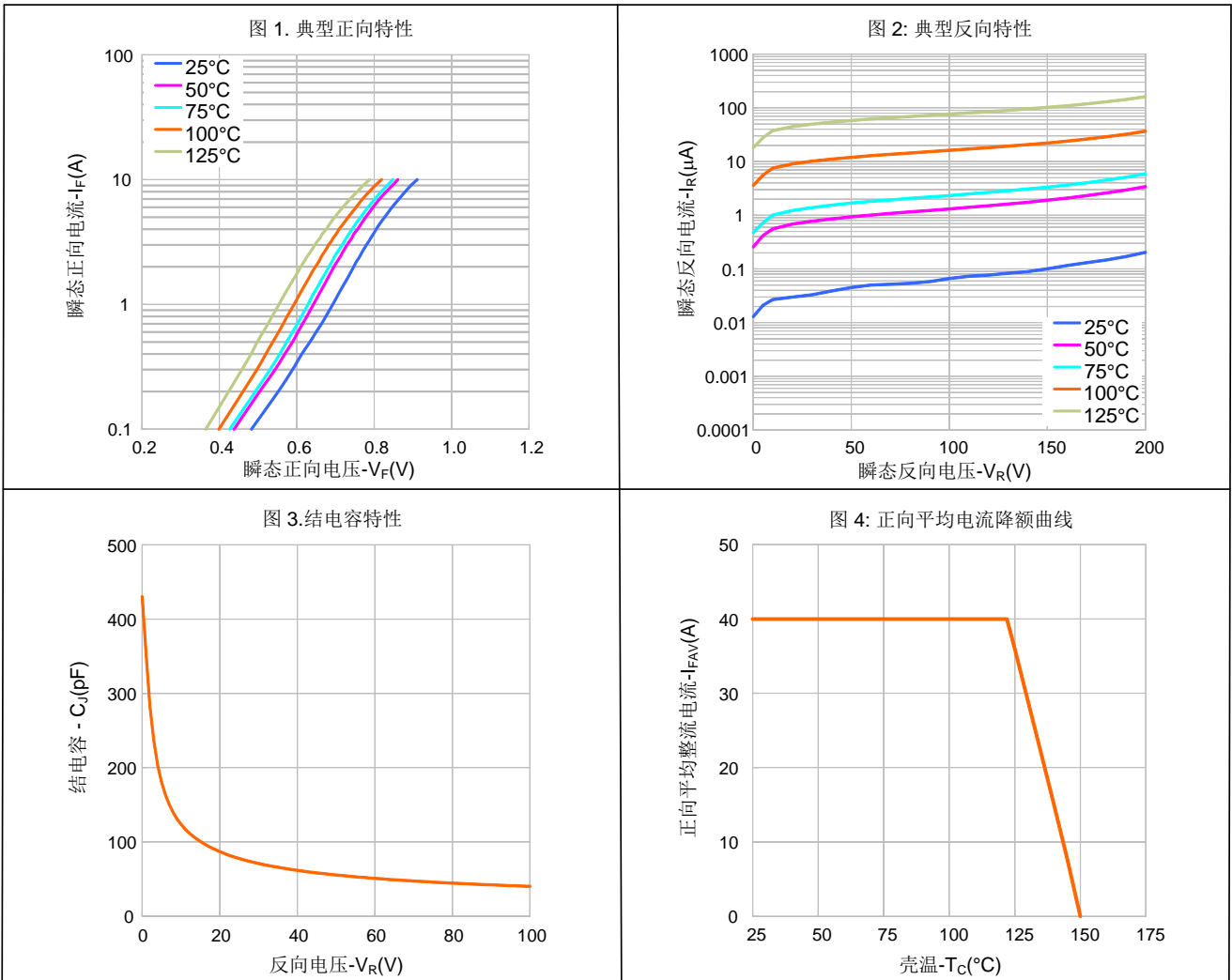
热阻特性

参数	符号	额定值	单位
芯片对管壳热阻 (TO-252封装)	$R_{\theta JC}$	2.0	$^\circ\text{C}/\text{W}$

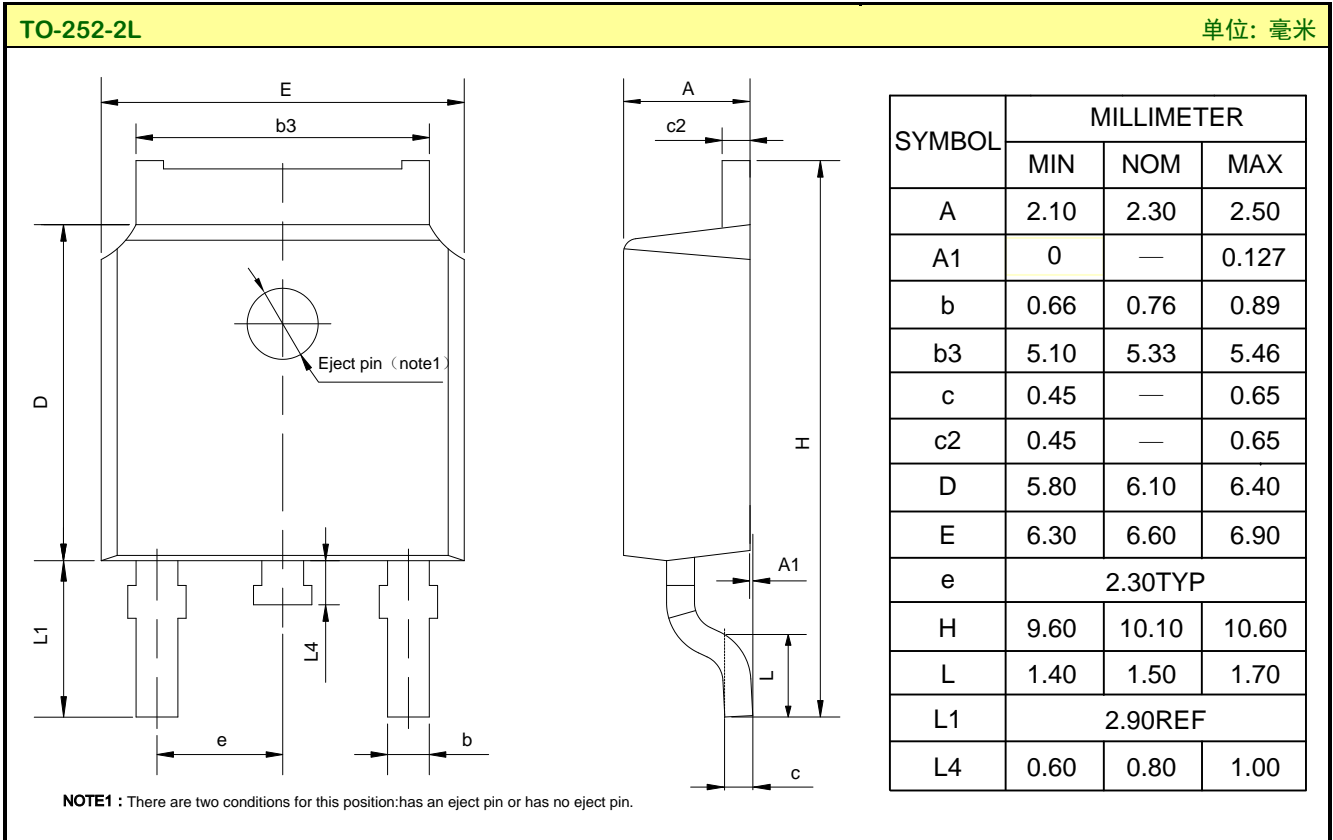
电参数规格

参数	符号	测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
正向压降	V_F	$I_F=5\text{A}$	$T_A=25^\circ\text{C}$	--	0.84	0.92	V
		$I_F=5\text{A}$	$T_A=125^\circ\text{C}$	--	--	0.80	V
反向漏电流	I_R	$V_R=200\text{V}$	$T_A=25^\circ\text{C}$	--	--	10	μA
		$V_R=200\text{V}$	$T_A=125^\circ\text{C}$	--	--	10	mA

典型特性曲线



封装外形图



重要注意事项：

1. 士兰保留说明书的更改权，恕不另行通知。
2. 客户在下单前应获取我司最新版本资料，并验证相关信息是否最新和完整。产品应用前请仔细阅读说明书，包括其中的电路操作注意事项。
3. 我司产品属于消费类电子产品或其他民用类电子产品。
4. 在应用我司产品时请不要超过产品的最大额定值，否则会影响整机的可靠性。任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能，买方有责任在使用我司产品进行系统设计、试样和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生。
5. 购买产品时请认清我司商标，如有疑问请与本公司联系。
6. 产品提升永无止境，我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！
7. 我司网站 <http://www.silan.com.cn>

产品名称:	SBD10C200AD	文档类型:	说明书
版权:	杭州士兰微电子股份有限公司	公司主页:	http://www.silan.com.cn

版本: 1.1

修改记录:

1. 更新曲线
-

版本: 1.0

修改记录:

1. 正式版本发布
-